

## In-Situ doped Amorphous Silicon 박막의 특성

라사균, 정호영, 양두영, 김우식, 김동원

금성 일렉트론 8 연구실

In-Situ P doped amorphous Si 박막은  $\text{Si}_2\text{H}_6$  및  $\text{PH}_3$  가스를 동시에 사용하여 저온 화학 증착법에 의해 성장 하였다. 저온 화학 증착법의 증착 변수에 따른 amorphous Si 과 Poly Si의 미세구조를 관찰 하였다. 또한 In-Situ P doped amorphous Si 박막의 dopant 거동, 전기저항 및 Step Coverage 특성도 관찰되었다. 마지막으로 이 박막의 우수성과 전기적 특성에 대하여 고찰하였다.